

**22.**

Denumirea invenției, în limba română	PROCEDEU DE OBȚINERE A MAI MULTOR REȚELE DE PORI INDEPENDENTE ÎN SUBSTRAT SEMICONDUCTOR PENTRU APLICAȚII FLUIDICE <b>(B)</b>
Denumirea invenției, în engleză	PROCESS FOR OBTAINING SEVERAL NON-CONNECTED PORE NETWORKS IN A SEMICONDUCTOR WAFER FOR FLUIDIC APPLICATIONS <b>(B)</b>
Autor / autori	Eduard Monaico, Veaceslav Ursaki, Ion Tiginyanu
Lucrare brevetată sau în curs de brevetare	a 2022 0001 din 24.01.2022

## UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Scurtă prezentare, în limba română	Două rețele de pori au fost produse prin anodizarea suprafeței plachetei semiconductoare acoperite cu o mască care conține găuri: (i) o rețea de pori primari, care se propagă sub mască într-o direcție paralelă cu suprafața probei și perpendicular pe marginea la mască; (ii) o rețea de pori secundari, care se propagă inițial în orificiul măștii în direcții radiale și ulterior își schimbă direcția de propagare în direcția porilor primari. Avantajele procedurii propus constau în posibilitatea obținerii mai multor rețele de pori independente în aceeași regiune folosind echipamente accesibile și tehnologii cost-efective. Autorii aduc mulțumiri proiectelor #21.00208.5007.15/PD și #20.80009.5007.20.
Scurtă prezentare, în limba engleză	Two pore networks were produced at anodization of the surface of semiconductor wafer covered with a mask contains holes: (i) a network of primary pores, which propagate under the mask in a direction parallel to the surface of the sample and perpendicular to the edge of the mask; (ii) a network of secondary pores, which initially propagate in the hole of the mask in radial directions and subsequently change their direction of propagation in the direction of the primary pores. The advantages of the proposed process consist in the possibility of obtaining several independent pore networks in the same region using accessible equipment and cost-effective technologies. Authors thanks to #21.00208.5007.15/PD and #20.80009.5007.20 projects.
Domeniul / domeniile de aplicabilitate	Are expected to be prospective for microfluidics and micro-electro-mechanical systems (MEMS). Nivele de laborator/prototip
Distincții obținute la alte saloane	